

Universität Stuttgart

Institut für Robuste Leistungshalbleitersysteme

M. Sc. Ruben Schnitzler Pfaffenwaldring 47, D-70569 Stuttgart, ruben.schnitzler@ilh.uni-stuttgart.de +49 (0) 711 685 68697 21.04.2022

In modern power electronics an ever increase in power density and efficiency is pursued. Therefore soft-switching of wide-bandgap semiconductors for high system performance is utilized. While high system advantages can be achieved, the prediction of those softswitching losses become particular difficult with electrical measurements. Therefore timeconsuming calorimetric measurements are utilized characterize to those accurately. Only recently time-efficient calorimetric measurement approaches have developed which simplifies extraction of the influence of several parameters. The output capacitance is the most influencial parameter on the switching deep analysis but dependencies is still missing. Since the output is dependent capacitance on parameters such as the gate source and source-drain capacitance.

Goal of this work:

- Implementing a SCPI-programmable DCsource for variable gate source voltage setting
- Measure the soft-switching losses for different gate source and gate drain voltages.
- · Extract the output capacitanc characteristic

Timeplan:

- Familirization & Literature research (10%)
- Implementing DC-Source (30%)
- Measurement (45%)
- Thesis writing and presentation (15%)

Helpful Previous knowledge:

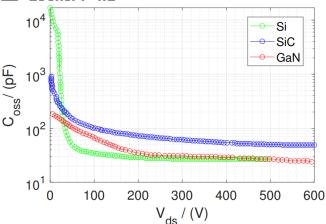
- Power electronics/ RPSS 1 & RPSS 2
- Matlab
- Altium/PCB-design

Research-/
Masterthesis

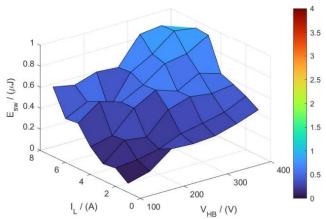
LE

Capacitance
Related SoftSwitching LossCharacterization
of Wide-Bandgap
Power
Semiconductors





Drain-source voltage-dependency of C_{oss} [1]



Measured soft-switching losses at different voltages [1]

[1] Rapid and Noninvasive Soft-Switching Characterization of Wide Bandgap Power Semiconductors Utilizing Automated and Highly Accurate Calorimetric Measurements Ruben Schnitzler 2022



Universität Stuttgart

Institut für Robuste Leistungshalbleitersysteme

M. Sc. Ruben Schnitzler Pfaffenwaldring 47, D-70569 Stuttgart, ruben.schnitzler@ilh.uni-stuttgart.de +49 (0) 711 685 68697 21.04.2022

In der modernen Leistungselektronik ist eine erhöhte Leistungsdichte Effizienz Dafür weichschaltende angestrebt. werden **Topologien** Wide-Bandgap mit Leistungshalbleitern verwendet, um die Systemperformance zu verbessern. Obwohl Systemverlustleistung deutlich reduziert werden kann, ist die Vorhersage der entstehenden Schaltverluste mittels elektrischer nicht möglich. Deshalb zeitintensive kalorimetrische Messungen durchgeführt, um diese Schaltverluste genau zu wurden 9 bestimmen. Erst kurzem vor zeiteffiziente Messmethoden entwickelt, um Schaltverluste systematisch untersuchen. Der wichtigste Parameter für die weichschaltenden Verluste ist hierbei die Ausgangskapazität, die insbesondere von der Gate-Source sowie der Drain-Source Spannung abhängig ist.

Ziel dieser Arbeit:

- Implementierung einer über SCPI-Programmierbaren DC-Quelle für das variable setzen der Gate-Source Spannung
- Weichschaltende Energie Bestimmung für unterschiedliche Gate-Source Spannungen
- Extraktion des Ausgangskennfeldes von C_{oss} .

Zeitplan:

- Einarbeitungszeit und Literaturrecherche (10%)
- Implementierung der ansteuerbaren V_{gs}-Quelle (30%)
- Messungen (45%)
- Ausarbeitung und Vortrag(15%)

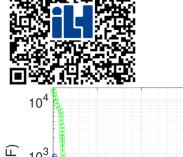
Hilfreiches Vorwissen:

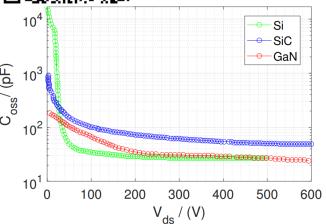
- Leistungselektronik/ RPSS 1 & RPSS 2
- Matlab
- Altium/ PCB-Design

Research-/
Masterthesis

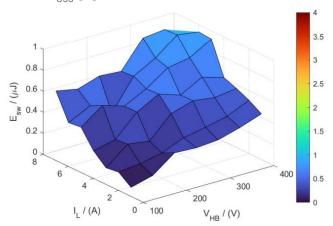
Kapazitätsabhängige weichschaltende Schaltverlust-Charakterisierung von Wide-Bandgap Leistungshalbleitern

LE





Drain-Source Spannungsabhängigkeit von C_{oss} [1]



Schaltverluste unterschiedlicher Drain-Source- Spannungen [1]

[1] Rapid and Noninvasive Soft-Switching Characterization of Wide Bandgap Power Semiconductors Utilizing Automated and Highly Accurate Calorimetric Measurements Ruben Schnitzler 2022

ı



Universität Stuttgart

Institut für Robuste Leistungshalbleitersysteme

M. Sc. Ruben Schnitzler Pfaffenwaldring 47, D-70569 Stuttgart, ruben.schnitzler@ilh.uni-stuttgart.de +49 (0) 711 685 68697 21.04.2022

In der modernen Leistungselektronik ist eine erhöhte Leistungsdichte Effizienz Daher werden weichschaltende Topologien mit Halbleitern mit großer Bandlücke verwendet um die Systemperformance zu verbessern. Obwohl so die Systemverlustleistung deutlich reduziert werden kann, die vorhersage ist entstehenden Schaltverluste mittels elektrischer nicht möglich. Deshalb werden zeitintensive kalorimetrische Messungen durchgeführt um diese Schaltverluste genau zu bestimmen. Erst vor kurzem zeiteffizienter Messmethoden entwickelt, die die Extrahierung unterschiedlicher Einflüsse erleichtern, deutlich eine aber übereinstimmende Simulation mit den gemessenen Schaltverlusten ist noch nicht möglich. Um eine tiefgreifender untersuchung unterschiedlicher Abhängigkeiten weichschaltenden Verluste zu erreichen wird eine Hybride herangehensweise von Simulation und Messung verfolgt. Darüberhinaus können die Simulationen auch für einen für virtuelles Prototyping und damit kosteneffizienten und verbessertes thermisches Lavout weichschaltenden Leistungskonverter ermöglichen.

Zeitplan:

- Einarbeitungszeit & Literaturrecherche (10%)
- Simulation von soft-switching losses und Verifizierung des Simulationsmodels (30%)
- Simulation verschiedener Gatetreiberschaltungen (45%)
- Ausarbeitung und Vortrag(15%)

Hilfreiches Vorwissen:

- Leistungselektronik/ RPSS 1 & RPSS 2
- Matlah
- LT-Spice/FEM-Simulationen www.ilh.uni-stuttgart.de

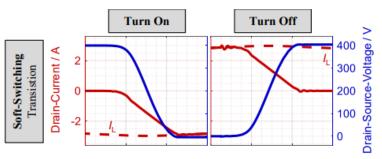
Research-/
Masterthesis

Simulationsbasierte Designoptimierung weichschaltender Leistungskonverter

LE

5 4 3 2 3 80 2 1 0 400 V_{SW}/V

Measured soft-switching energies of a SiC-MOSFET [1]



Simulated soft-switching losses of a SiC-MOSFET [2]

[1] Rapid and Noninvasive Soft-Switching Characterization of Wide Bandgap Power Semiconductors Utilizing Automated and Highly Accurate Calorimetric Measurements Ruben Schnitzler 2022

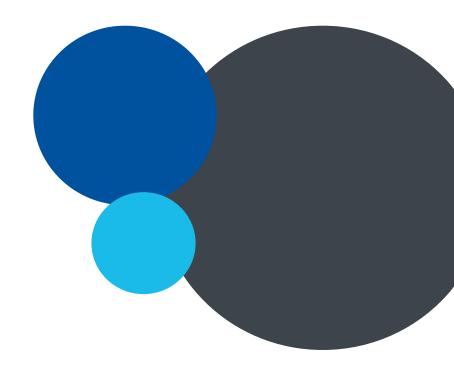
[2] Weimer, J., Koch, D., & Kallfass, I. (2021, September). Accuracy study of calorimetric switching loss energy measurements for wide bandgap power transistors. In 2021 23rd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'21 ECCE Europe) (pp. P-1). IEEE.



University of Stuttgart

Institute of Robust Power Semiconductor Systems

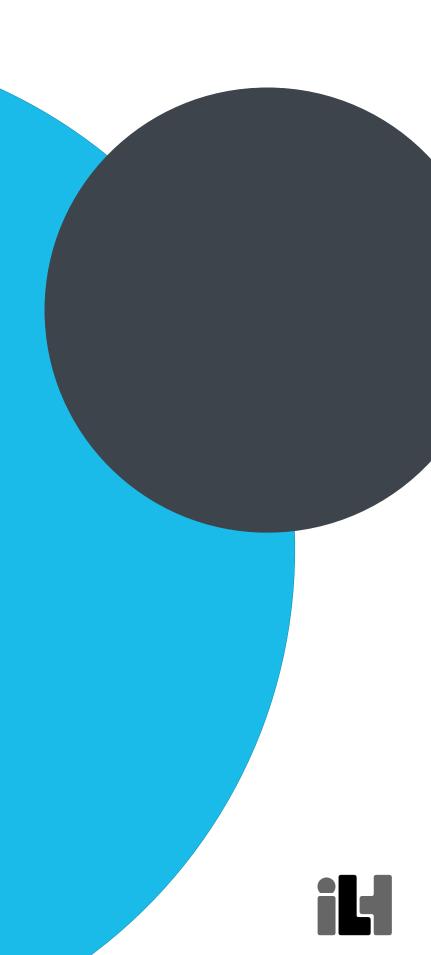
21.04.2022







Leistungshalbleitersysteme











21.04.2022

Bachelorarbeit / Forschungsarbeit / Masterarbeit

Clear description incl. pictures, conveying motivation, tasks and goals.





Semiconductor Systems

21.04.2022

- Bachelor Thesis / Study Thesis / Master Thesis
- Clear description incl. pictures, conveying motivation, tasks and goals.

